

NPN HIGH POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/371

Devices

2N3902

2N5157

Qualified Level

**JAN
JANTX**

MAXIMUM RATINGS

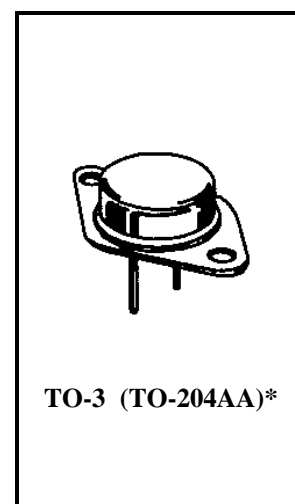
Ratings	Symbol	2N3902	2N5157	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	400	500	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	6.0	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	700		Vdc
Base Current	I_B	2.0		Adc
Collector Current	I_C	3.5		Adc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ ⁽¹⁾	5.0	W
		@ $T_C = +75^{\circ}\text{C}$ ⁽²⁾	100	W
Operating & Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.25	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

1) Derate linearly 29 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > +25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly 0.8 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > +75^{\circ}\text{C}$



*See Appendix A for Package Outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 325 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 400 \text{ Vdc}$	2N3902 2N5157	I_{CEO}	250 250	μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}; V_{CE} = 700 \text{ Vdc}$		I_{CEX}	500	μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 6.0 \text{ Vdc}$	2N3902 2N5157	I_{EBO}	200 200	μAdc

ON CHARACTERISTICS⁽³⁾

Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 1.0 \text{ Adc}; I_B = 0.1 \text{ Adc}$ $I_C = 3.5 \text{ Adc}; I_B = 0.7 \text{ Adc}$		$V_{BE(sat)}$	1.5 2.0	Vdc
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 1.0 \text{ Adc}; I_B = 0.1 \text{ Adc}$ $I_C = 3.5 \text{ Adc}; I_B = 0.7 \text{ Adc}$		$V_{CE(sat)}$	0.8 2.5	Vdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS⁽³⁾ (con't)				
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.5 Adc; V _{CE} = 5.0 Vdc I _C = 1.0 Adc; V _{CE} = 5.0 Vdc I _C = 2.5 Adc; V _{CE} = 5.0 Vdc I _C = 3.5 Adc; V _{CE} = 5.0 Vdc	h _{FE}	25 30 10 5	90	
Collector-Emitter Sustaining Voltage I _C = 100 mAdc	V _{CEO(sus)}	2N3902 2N5157	325 400	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 0.2 Adc; V _{CE} = 10 Vdc, f = 1 MHz	h _{fe}	2.5	25	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc; I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		250	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time V _{CC} = 125 Vdc; I _C = 1.0 Adc; I _{B1} = 0.1 Adc	t _{on}		0.8	μs
Turn-Off Time V _{CC} = 125 Vdc; I _C = 1.0 Adc; I _{B1} = 0.1 Adc; -I _{B2} = 0.50 Adc	t _{off}		1.7	μs

SAFE OPERATING AREA**DC Tests (continuous)**T_C = +25°C; t ≥ 1.0 s (See Figure 3 of MIL-PRF-19500/371)**Test 1**V_{CE} = 28.6 Vdc, I_C = 3.5 Adc**Test 2**V_{CE} = 70 Vdc, I_C = 1.43 Adc**Test 3**V_{CE} = 325 Vdc, I_C = 55 mAdc 2N3902V_{CE} = 400 Vdc, I_C = 35 mAdc 2N5157**Switching Tests****Load condition C (unclamped inductive load)**T_C = 25°C; duty cycle ≤ 10%; R_S = 0.1 Ω (See Figure 4 of MIL-PRF-19500/371)**Test 1**t_p = approximately 3 ms (vary to obtain I_C); R_{BB1} = 20 Ω; V_{BB1} = 10 Vdc; R_{BB2} = 3 kΩ;V_{BB2} = 1.5 Vdc; V_{CC} = 50 Vdc; I_C = 3.5 Adc; L = 60 mH; R = 3 Ω; R_L ≤ 14Ω.**Test 2**t_p = approximately 3 ms (vary to obtain I_C); R_{BB1} = 100 Ω; V_{BB1} = 10 Vdc; R_{BB2} = 3 kΩ;V_{BB2} = 1.5 Vdc; I_C = 0.6 Adc V_{CC} = 50 Vdc; L = 200 mH; R = 8 Ω; R_L ≤ 83Ω.**Switching Tests****Load condition (clamped inductive load)**T_C = +25°C; duty cycle ≤ 10%. (See Figure 5 of MIL-PRF-19500/371)**Test 1**t_p = approximately 30 ms (vary to obtain I_C); R_S = 0.1 Ω; R_{BB1} = 20 Ω; V_{BB1} = 10 Vdc; R_{BB2} = 100 Ω;V_{BB2} = 1.5 Vdc; V_{CC} = 50 Vdc; I_C = 3.5 Adc; L = 60 mH; R = 3 Ω; R_L ≥ 0Ω.

(A suitable clamping circuit or diode can be used.)

Clamp Voltage = 400 +0, -5 Vdc 2N3902

Clamp Voltage = 500 +0, -5 Vdc 2N5157

(Clamped voltage must be reached)

3.) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.